

Сведения и публикации официального оппонента
по диссертационной работе Ефимова Александра Сергеевича
на тему «Интеграция кристаллов полупроводниковых СВЧ приборов
с применением метода перевернутого монтажа на основе тонкоплёночной
системы металлов Au-Sn»
по специальности 2.2.2 – «Электронная компонентная база
микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств»
на соискание учёной степени кандидата технических наук

Фамилия, имя, отчество	Миннебаев Вадим Минхатович
Учёная степень, учёное звание (при наличии)	кандидат технических наук, доцент
Наименование отрасли науки, научной специальности, по которой защищена диссертация	05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Полное наименование организации, которое является основным местом работы	Акционерное общество «Микроволновые системы»
Краткое наименование организации	АО «Микроволновые системы»
Ведомственная принадлежность	
Должность	Заместитель генерального директора по развитию ЭКБ
Почтовый индекс, адрес	105112, г. Москва, Щёлковское ш., д. 5, стр. 1, помещ. 100
Веб-сайт	www.mwsystems.ru
Телефон	+7 499 650 80 67
Адрес электронной почты	mwsystems@mwsystems.ru, vm@mwsystems.ru

Основные публикации по профилю оппонируемой диссертации
за последние 5 лет

1. Опыт производства многоканальных приемопередающих модулей АФАР X-диапазона на основе МИС собственной разработки / А. А. Кищинский, К.Ю. Череев, П.А. Косолапов [и др.] // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2023. – № 4(271). – DOI: 10.36845/2073-8250-2023-271-4-4-13. – С. 4-13. EDN TRXTKW/
2. Особенности проектирования АФАР радиолокационных комплексов с применением СВЧ интегральных схем собственной разработки / А. А. Кищинский, В. Г. Чернов, А. В. Кондратенко [и др.] // Электронная техника. Серия 1: СВЧ-техника. – 2023. – № 3(559). – С. 82-95. – EDN FFQCDT.
3. СВЧ-компоненты на основе технологии нитрида галлия: что изменилось за два года / А. Кищинский, В. Миннебаев // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2023. – № 1(222). – С. 42-51. – DOI 10.22184/1992-4178.2023.222.1.42.50. – EDN YQRRKK.
4. Мы стремимся разрабатывать компоненты, которые позволят потребителю создать лучшее изделие / В. Миннебаев // Электроника: Наука, технология, бизнес.

– 2022. – № 6(217). – С. 12-19. – DOI 10.22184/1992-4178.2022.217.6.12.18. – EDN RIQLUS.

5. Оценка разрешения высокодетальной твердотельной системы ДЗЗ околосемного базирования Хдиапазона с подтверждением натурным экспериментом / Р. С. Болтиков, С. В. Болтиков, Ю. В. Бурцев [и др.] // Наноиндустрия. – 2022. – Т. 15, № S8-1(113). – С. 346-351. – DOI 10.22184/1993-8578.2022.15.8s.346.351. – EDN TLPHBA.

6. Монолитная интегральная схема СВЧ аттенюатора на AlGaN/GaN гетероструктурах / А. С. Адонин, А. Ю. Евграфов, В. М. Миннебаев, А. В. Редька // Системный анализ, управление и навигация : XXV международная научная конференция : тезисы докладов, Евпатория, 04–11 июля 2021 года / Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), АНО ДПО «Космос - образование». – Москва: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2021. – С. 111-112. – EDN MTJTTY.

7. Электромагнитное моделирование монолитной интегральной схемы СВЧ аттенюатора на AlGaN/GaN гетероструктурах / А. С. Адонин, А. Ю. Евграфов, Ю. В. Колковский, В. М. Миннебаев // Микроэлектроника. – 2021. – Т. 50, № 3. – С. 228-235. – DOI 10.31857/S0544126921020022. – EDN NOGQLG.

8. Приемный тракт миллиметрового диапазона с подавлением зеркального канала / А. В. Редька, В. М. Миннебаев, В. В. Краснов // Наноиндустрия. – 2021. – Т. 14, № S7(107). – С. 435-437. – DOI 10.22184/1993-8578.2021.14.7s.435.437. – EDN TWOLWT.

9. Оценка разрешения высокодетальной твердотельной системы ДЗЗ околосемного базирования Х-диапазона с подтверждением натурным экспериментом / Р. С. Болтиков, С. В. Болтиков, Ю. В. Бурцев [и др.] // Наноиндустрия. – 2021. – Т. 14, № S7(107). – С. 443-446. – DOI 10.22184/1993-8578.2021.14.7s.443.446. – EDN AXRUTV.

10. Электрические механизмы деградации полевых гетероструктурных транзисторов на основе нитрида галлия / В. М. Миннебаев // Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. – 2021. – № 3(262). – С. 4-24. – DOI 10.36845/2073-8250-2021-262-3-57-60. – EDN CATPKN.

11. Исследование нитрид-галлиевых малошумящих усилителей при криогенных температурах / Д. Г. Алипа, В. В. Краснов, В. М. Миннебаев [и др.] // Наноиндустрия. – 2020. – № S96-1. – С. 347-352. – DOI 10.22184/1993-8578.2020.13.3s.347.352. – EDN RYONZS.

Официальный оппонент

В.М. Миннебаев

Подпись В.М. Миннебаева заверяю

Инспектор по кадрам
АО «Микроволновые системы»



А.А. Ракович